铒配合物的红外有机电致发光

洪自若¹,梁春军¹,赵 丹¹,李锐钢²,李文连^{1,2,*}

(1. 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所, 吉林 长春 130021; 2. 中国科学院激发态物理开放研究实验室, 吉林 长春 130021)

摘要:研究了三价铒离子配合物在近红外区段的电致及光致发光特性。采用双层电致发光器件获得了铒离 子位于 1 530nm 的光发射,并通过改进后的三层结构器件使铒离子的红外发射明显提高,首次获得了 Er (DBM) 3bath 在 977nm 和 1 530nm 的发射。总结不同电流密度下的系列发射光谱强度变化规律,发现随电流 密度增大,虽然光谱强度的增长呈近似线性,但相对效率却在急剧下降,对这一现象做了初步讨论。器件在可 见区有发光,其来源被归结为激基复合物的发射。

关 键 词: 红外发光; 有机电致发光; 铒配合物 中图分类号: TN 873.3 文献标识码: A 文章编号: 1000-7032(2000)03-0269-04

1引言

有机材料的发射光谱范围可覆盖近紫外和整 个可见区域。有机电致发光(OEL)由于近十多年 来的飞速发展,已成为平板显示、发光领域的重要 研究方向,在实际应用方面已经初步实现产业化。 随着研究工作的进一步深入,人们的目光已经开 始从电致发光(EL) 向有机固体电泵 浦激光扩 展^[1]。稀土配合物作为 OEL 发光材料, 已经得到 了红^[2]、绿^[3]、蓝^[4]及白色发光。但围绕稀土配 合物在红外(IR)波段发光的研究多数限于溶液 内的光致发光(PL)^[5~7],稀土配合物电激发条件 下红外发光特性的研究仅见于少数报道^[8,9]。由 于稀土材料具有作为激光工作物质的某些特点: 发射峰与吸收峰偏离大,发光寿命长(毫秒量级), 发光效率较高(能有效利用三重态激子^[10])等,有 可能成为电泵浦激光的发光材料。三价铒离子是 无机激光晶体和玻璃中有效且常用的发光中心。 Er³⁺ 的 f f 辐射跃迁在可见及红外区域内有多个 发射峰,具有多个激光通道。 Er^{3+} 离子最主要的 发光波段是近红外区 1.54µm, 这一波段的光波 同时又是石英光纤最有效的透射窗口,因此获得 该波段电致发光对光纤通讯有重要实用意义。目 前获得该波段发射的一般方法是采用光激发含铒 离子的无机样品。

本文主要研究了稀土铒配合物在红外区间的

EL 特性, 观察到铒离子位于 1.544m 处强度较高的发射。由此为探索有机红外电泵浦激光的可行性提供了工作基础。

2 实 验

实验中使用的材料分子式如图 1 所示,包括: 空穴传输材料 N, N'-二苯基-N, N'-二(2 甲基苯基)-1,1'-二苯基4,4'-二胺(TPD),聚乙烯基咔唑 (PVK,由本实验室自行合成的,分子量 10 000 左 右),铒配合物(Er(DBM)3bath,Er(AcA)3phen,Er (AcA)3bath)作为发光及电子传输材料,其中DBM 为二苯甲酰基甲烷,bath为4,7二苯基1,10 邻菲 罗啉,AcA 为乙酰丙酮,phen为1,10-邻菲罗啉。

器件制备过程中,除 PVK 薄膜采用旋转涂 覆法(40 毫克 PVK 溶于 50 毫升三氯甲烷中,旋 涂速度每分钟 2 000 转,厚度约 100nm)外,其余 各层均在 2×10⁻⁴Pa 高真空下热蒸镀而成。在镀 有铟锡氧化物阳极(ITO,面电阻 100Ω/□)的玻 璃基板上依次蒸镀或旋涂各功能层,再在顶端蒸 镀一层 150nm 厚镁银合金阴极(镁银比例约 10: 1)。器件发光面积为 3×4mm²。所有真空中的 镀膜操作一次性完成,制得的器件在高纯氮气氛 下封装以备测试。器件在可见区(400~750nm) 发射光谱由日立-4000 光谱仪测得,红外区的发 射光谱使用装有液氮冷却低温锗探测器和488nm 氩离子激光器的 BioradPL-9000FT 型近红外光谱

收稿日期: 2000-05-15

基金项目: 国家 863 基金资助项目: (863-715-002-031)

作者简介:洪自若(1974-),男(回族),吉林通榆人,现读博士学位,从事稀土有机电致发光研究。

^{*:}通讯联系人: E- mail: pjblw1@ public. cc. jl. cn



图 1 所用主要材料分子式 Fig. 1 Formula of materials used in this study.

3 结果与讨论

正向偏压下,双层器件 ITO/TPD(50nm)/Er (DBM) 3bath(80nm)/Mg:Ag 的红外光谱表现为 1 534nm 处发射峰,半高宽(FWHM)约40nm。根 据 Er³⁺ 离子的能级图判断,此发射源于⁴I_{13/2} ⁻ ⁴I_{15/2}跃迁。但该器件在电流密度大于50mA/cm² 时,红外发射强度明显衰减。仅测得器件在 5mA 以内的发射强度-电流、相对效率-电流的相互关 系,如图 2 所示。其中的发射强度是以光谱中 1 530nm处发射峰积分强度表示,相对效率为器 件在原位不动情况下发射强度与相应电流的比 值。但不同器件的发射强度和相对效率不具有可 比性。从中明显看出,虽然强度随电流的增长呈 线性,但与此同时,相对效率呈下降趋势。观察



图 2 双层器件 ITO/TPD(50nm)/Er(DBM)₃bath (80nm)/Mg: Ag 的发射强度 电流(A)、相对效 率 电流(B)曲线

Fig. 2 (A) dependence of emitting intensities on current;
(B) dependence of relative efficiency on current in bilayer device ITO/TPD(50nm)/Er(DBM)₃bath (80nm)/Mg Ag.

表明,电流超过 5mA 时,即使在光谱仪扫描取样 的短时间(1min)内,发射强度就在逐渐减低。原 因可能在于电流的增长对器件产生不可恢复的破 坏作用。

为了改善器件的电流注入性能,并考虑到由 ITO 阳极注入空穴可能造成对 DBM 配合物的破 坏作用和对发光的猝灭作用^[2],我们制成了三层 结构器件,在 TPD 和铒配合物之间夹一层 TPD 和铒配合物的混杂层, TPD 与 Er(DBM)₃bath 重量比 约 为 1: 1, ITO/TPD (30nm)/Er (DBM)₃bath: TPD (30nm)/Er(0BM)₃bath (60nm)/Mg Ag。从实验结果看,该结构大幅度 提高了器件对电流的承受能力。图 3 给出了器件 在 20mA 电流下典型的铒离子红外发射光谱和 488nm激发下固体样品PL 光谱。其中977nm和



- **メ/ma** 图 3 典型铒配合物的红外 EL(实线, 三层器件 IT O/ TPD (30nm)/Er(DBM)3bath: TPD(30nm)/Er(DBM)3bath (60nm)/Mg: Ag, 电流密度200mA/cm², 驱动电压 20.5V)和 PL(虚线, 室温下 488nm 激光激发)光谱
- Fig. 3 Infrared emission (solid line) from trilayer EL device IT O/TPD(30nm)/Er(DBM) 3bath: TPD(30nm)/ Er(DBM) 3bath(60nm)/Mg: Ag and PL spectrum (dot line) excited by 488nm laser.

1 530nm 两发射峰, 分别对应于铒离子⁴I_{11/2} → 4 I_{15/2}和⁴I_{13/2} → 4 I_{15/2}跃迁。该发射光谱及器件电 学特性与文献[9]中报道相比, 有显著改善。但限 于条件, 不能得出器件的红外发射效率。如图 4 所示, 尽管器件的发射强度随电流的增长呈线性, 相对效率随电流的下降趋势并未得到明显改善。 这说明导致器件效率下降的因素不仅是电流的不



可逆损伤,另有其它机制存在。EL 光谱和 PL 光 谱相比较,发现 EL 光谱中很明显的⁴I_{11/2}^{→4}I_{15/2}跃 迁在 PL 光谱中没有出现,而⁴I_{11/2}^{→4}I_{15/2}跃迁的强 度基本相近。据此判断,EL 和 PL 的机制有不同之 处。但进一步的研究还需要引入不同波长的光源 进行选择激发,来确定具体的发光过程。

EL器件的红外发射总是伴随着可见区的发



- 图 4 三层器件 ITO/TPD(30nm)/Er(DBM)3bath: TPD(30nm)/Er(DBM)3bath(60nm)/Mg Ag 的发射强度 电流(A)、 相对效率 电流(B)曲线
- Fig. 4 (A) dependence of emitting intensities on current; (B) dependence of relative efficiency on current in trilayer device IT O/TPD(30nm)/Er(DBM)3bath:TPD(30nm)/Er(DBM)3bath(60nm)/Mg Ag.

光(光谱如图 5 所示)。双层和三层器件的光谱有 着显著区别,且二者都与 TPD 和 Er(DBM)₃bath 的可见区的 PL 光谱截然不同。造成这种现象的 原因是配体 TPD 之间形成的激基复合物^[11]。可 见区和红外区的发射是相互竞争的过程,为了提





参考文献:

高红外发射强度和效率,都应避免可见区的发光。 用 PVK 代替 T PD 制成的双层器件同样有很弱的 可见光发射,观测到的红外发光很弱,认为主要是 PVK 的空穴注入效果太差导致载流子失衡。由 此可见材料体系的选择,对避免激基复合物的形 成,从而增强红外工真空蒸发过程中发光很重要。

本研究中尝试采用了几种其它铒配合物,但 有不同程度的加热分解现象,在很高电压下,只有 很小电流通过,效果都很差,难以得到明显的红外 发射。结构为 ITO/PVK/Er(AcA)3phen/Mg:Ag 的器件仅在较大电压下有微弱的 1 530nm 处的 发射。

4 结 论

我们在几种铒配合物中经过选择实验,确定 了 Er(DBM)3bath 有较好的红外电致发光性能。 首次利用铒配合物 Er(DBM)3bath 制成了双层及 多层 EL 器件,观察到1 530nm 波长的红外发射, 并对不同结构的器件特性做了相对比较。

- [1] Kozlov V G, Bulovic V, Burrows P E, Forrest S R. Laser action in organic semiconductor waveguide and double-heterostructure devices [J]. Nature, 1997, 389: 362-364.
- [2] Liang Chunjun, Zhao Dan, Hong Ziruo, et al. Improved performance of electroluminescent devices based on an europium complex [J]. Appl. Phys. Lett., 2000, 76:67-69.
- [3] Gao Xicun, Cao Hong, Huang Chunhui, et al. Electroluminescence from both a ligh+emitting layer and hole transport layer: spectral evidence for charge carrier tunneling injection [J]. Chemical Physics Letters, 1998, 297: 530-536.
- [4] Hong Ziruo, Li Wenlian, Zhao Dongxu, et al. Spectral narrow blue light emitting organic electroluminescent devices utilizing thulium complexes [J]. Syn. Met., 1999, 104: 165-167.

- [5] Iwamuro M, Hasegawa Y, Wada Y, et al. First observation of photosensitized luminescence of Nd³⁺ in organic solution [J]. Chem. Lett., 1997, (10):1067-1068.
- [6] Sloof L H, Polman Oude Wolbers A, van Veggel M P, et al. Optical properties of erbium-doped organic polydentate cage complexes [J]. J. Appl. Phys., 1998, 83:497-503.
- [7] Klink S I, Hebbink G A, Grave L, van Veggel F C J M, et al. Sensitized near-infrared luminescence from polydentate triphenylene-functionalized Nd³⁺, Yb³⁺, and Er³⁺ complexes [J]. J. Appl. Phys., 1999, 86:1181-1885.
- [8] Kawamura Y, Wada Y, Hasegawa Y, et al. First observation of infrared electroluminescence from Nd complex [J]. Appl. Phys. Lett., 1999, 74: 3245-3247.
- [9] Curry R J, Gillin W P. 1.54¹m electroluminescence from erbium (III) tris(8-hydroxyquinoline)(ErQ)-based organic light-emitting diodes [J]. Appl. Phys. Lett., 1999, 74:13801382.
- [10] Liang Chunjun. Electroluminescence of rare earth complexes and theoretical model of organic electroluminescent devices [D]. Changchun: paper for doctoral degree submitted to Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, 2000.
- [11] Liang Chunjun, Zhao Dan, Hong Ziruo, et al. Exciplex emissions in bilayer and doped thin films containing non-fluorescence gadolinium complex [J]. Thin Solid film., 2000, 371: 207-211.

Infrared Light-Emitting Devices Based on Organic Erbium Complexes

HONG Zi ruo¹, LIANG Chun jun¹, ZHAO Dan¹, LI Rui gang², LI Wen-lian^{1,2}

(1. Laboratory of Excifted States Processes, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130021, China;

2. Changchun Institute of Optics, Fine Mechanics and Physics, Chinese Academy of Sciences, Changchun 130021, China)

Abstract: Unique luminescent properties of rare earth ions in inorganic and organic matrices have been the subject of many studies for many years, including both photoluminescence and electroluminescence. The Er^{3+} ion has a sharp luminescence centered at 1 530nm due to an intra 4f shell transition between the first excited state (${}^{4}I_{13/2}$) and the ground state (${}^{4}I_{15/2}$). Considering the potential use of trivalent erbium complexes as IR emitting materials for optical quartz fiber communication and laser application, we concentrated in organic electroluminescence (EL) from Er^{3+} in IR range. Except for notable advantages of current excitation over photo excitation, probability of realizing electric pump laser from Er^{3+} , which is a usual emitting center in inorganic laser crystals and glasses, is another attractive purpose of this study.

Er(DBM) sbath and several kinds of other Er complexes were synthesized according to traditional method in our lab. Bilayer and trilayer EL devices based on Er(DBM) sbath were fabricated. Two intense bands at 1530nm and 977nm originated from trivalent Er^{3+} ion were observed under a low DC voltage for the first time.

Individual organic films and alloy cathode of EL devices were deposited onto indium tin oxide glass substrate successively by thermal evaporation in a vacuum chamber at 5×10^{-4} Pa. The made-up devices were encapsulated in dried nitrogen. IR(700~ 2000nm) and visible (400~ 750nm) spectra were measured by a Biorad PL-9000FT spectrometer and a Hitach-4000 fluorescence spectrophotometer at room temperature, respectively. From ITO/TPD (30nm)/Er (DBM) 3bath doped TPD (30nm) (about 1: 1)/Er (DBM) 3bath (60nm)/Mg Ag(150nm) (device I), intense emitting band locating at 1530 nm corresponding to ${}^{4}I_{13/2} \xrightarrow{\rightarrow} {}^{4}I_{15/2}$ transitions of Er³⁺ was observed. Almost pure emissions from Er³⁺ were obtained including a weaker peak at 977nm, which was originated from ${}^{4}I_{11/2} \xrightarrow{\rightarrow} {}^{4}I_{15/2}$ transition. IR emissions were accompanied by visible emitting for both bilayer and trilayer devices. Emitting spectra of the two types of devices were quite different. This indicates that radiative decay of the low est excited state of ligand occurred through not only ff transition of Er³⁺ ion but also other ways.

Key words: infrared emission; organic electroluminescence; Er-complex